

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年3月17日(2005.3.17)

【公開番号】特開2002-176190(P2002-176190A)

【公開日】平成14年6月21日(2002.6.21)

【出願番号】特願2000-373113(P2000-373113)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 31/10

H 01 L 27/14

【F I】

H 01 L 31/10 A

H 01 L 27/14 Z

【手続補正書】

【提出日】平成16年4月12日(2004.4.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

SOI基板と、前記SOI基板に形成されたアンプ部と、前記SOI基板に形成されたフォトダイオード部とを有する光半導体集積回路装置において、

前記フォトダイオード部のSOI層は、前記SOI基板の表面側の不純物濃度が前記SOI基板の絶縁膜側の不純物濃度よりも小さいことを特徴とする光半導体集積回路装置。

【請求項2】

情報を記録した光ディスクと、半導体レーザ光源と、前記半導体レーザ光源からの出射光を前記光ディスクに集光する光学系と、前記光ディスクからの反射光を検出する光検出器と、前記光検出器で検出された信号を処理する信号処理部とを含む光記憶再生装置において、

請求項1記載の光半導体集積回路装置により前記反射光の検出と、前記検出された信号の少なくとも一部の処理を行うことを特徴とする光記憶再生装置。